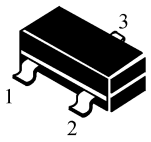
KEL®

MMBTA06

SOT—23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■MAXIMUM RATINGS 最大額定值(T_a=25℃)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	80	Vdc
-Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	80	Vdc
Emitter-Base voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	4.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	Ic	500	mAdc
Base-Current 基極電流	I_B	50	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	300	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	℃
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55～150	℃

■DEVICE MARKING 打標

MMBTA06=1GM

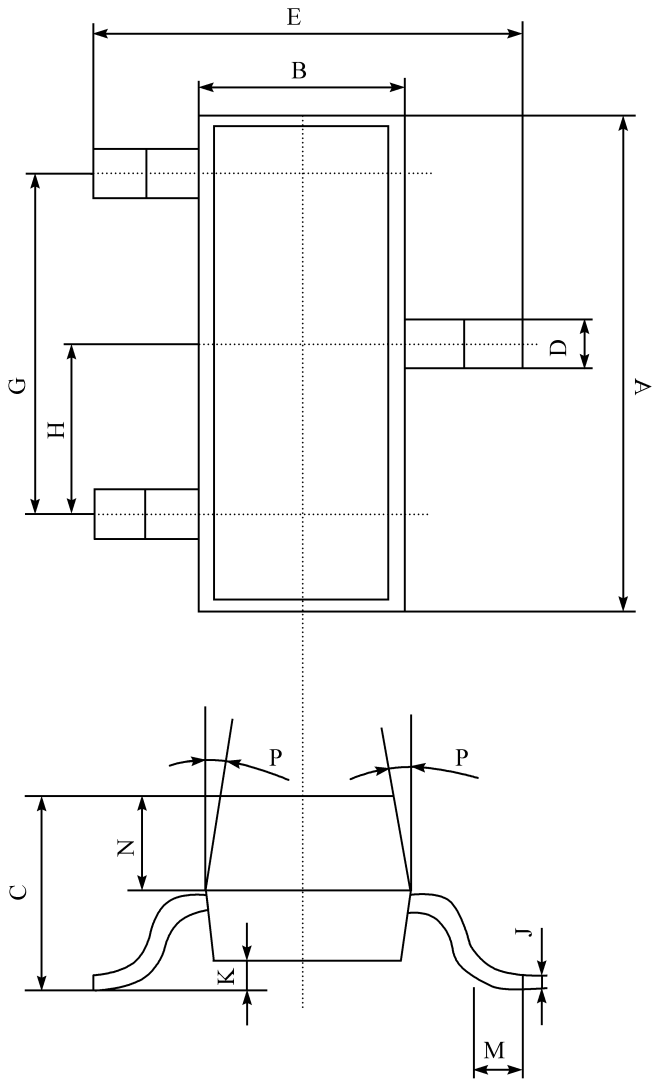
■ELECTRICAL CHARACRTERISTICS 電特性

(T_A=25℃ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度爲 25℃**)**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	V_{CB}=80V,I_E=0	—	—	0.1	μA
Collector Emitter Current 集電極發射極電流	I_{CES}	V_{CE}=60V, V_{BE}=0	—	—	0.1	μA
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	I_C=100 μA	80	—	—	V
Collect-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	I_C=1.0mA	80	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	I_E=100 μA	4	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h_{FE}(1)	V_{CE}=1V,I_C=10mA	100	—	—	—
	h_{FE}(2)	V_{CE}=1V,I_C=100mA	100	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	I_C=100mA, I_B=10mA	—	—	0.25	V
Base-Emitter Saturation Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	V_{CE}=1V,I_C=100mA	—	—	1.2	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	V_{CE}=2V,I_C=10mA	100	—	—	MHz

MMBTA06

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90±0.10
B	1.30±0.10
C	1.00±0.10
D	0.40±0.10
E	2.40±0.20
G	1.90±0.10
H	0.95±0.05
J	0.13±0.05
K	0.00-0.10
M	≥0.2
N	0.60±0.10
P	7±2°